

委員各位

日本学術振興会ワイドギャップ半導体  
光・電子デバイス第 162 委員会  
委員長 吉川 明彦

日本学術振興会ワイドギャップ半導体光・電子デバイス第 162 委員会  
第 85 回委員会・第 89 回研究会 開催案内  
(先端ナノデバイス・材料テクノロジー第 151 委員会と合同研究会)

日時：平成 26 年 5 月 9 日 (金)

委員会：12:00 - 12:50

研究会：13:00 - 17:30

意見交換会：18:00 - 20:00

場所：主婦会館プラザエフ (東京、四ツ谷)

委員会/研究会：B 2 F クラルテ、意見交換会：9 F スズラン

〒102-0085 東京都千代田区六番町 15 番地, TEL: 03-3265-8111、URL: <http://www.plaza-f.or.jp/>

## 委員会

議題：

- (1) 前回第 84 回委員会議事要録承認について
- (2) 委員の異動について
- (3) 役員構成の変更について
- (4) 次回第 86 回研究会以降の研究会について
- (5) その他

報告事項：

- (1) 学振の規定について
- (2) 書籍「ワイドギャップ半導体 あげぼのから最前線へ」の寄贈について
- (3) 特別事業計画 (シンポジウム) 援助の採択 (APWS2014)
- (4) ワイドギャップ半導体スクールについて
- (5) 応用物理学会 応用電子物性分科会 (6/5 開催：名古屋大学) について
- (6) 応用物理学会 結晶工学分科会 (6/6 開催：名古屋大学) について
- (7) 日本結晶成長学会 窒化物半導体結晶成長講演会 (7/25-26 開催：名城大学) について
- (8) その他

**研究会** 主 題：「ワイドギャップ半導体パワーデバイス研究開発の最前線」

「委員長挨拶・企画の趣旨説明」(13:00 ~ 13:05)

1. 「SiC と GaN がもたらすメカトロパラダイムシフト」(13:05-13:45)  
樋口 雅人 (株式会社安川電機 技術開発本部 開発研究所)
2. 「SiC パワーデバイスの開発状況」(13:45-14:25)  
古橋 壮之 (三菱電機株式会社 先端技術総合研究所)
3. 「GaN-on-Si パワーデバイスとその応用」(14:25-15:05)  
田中 毅 (パナソニック株式会社 AIS グリーンイノベーション開発センター)

休 憩 (15:05-15:30)

4. 「ダイヤモンドパワーデバイス」(15:30-16:10)

山崎 聡 (産業技術総合研究所 エネルギー技術研究部門)

5. 「酸化ガリウムトランジスタ開発の現在までの進展と今後」(16:10-16:50)

東脇 正高<sup>1</sup>、佐々木 公平<sup>2,1</sup>、Man Hoi Wong<sup>1</sup>、上村 崇史<sup>1</sup>、  
Daivasigamani Krishnamurthy<sup>1</sup>、倉又 朗人<sup>2</sup>、増井 建和<sup>3</sup>、山腰 茂伸<sup>2</sup>  
(<sup>1</sup>情報通信研究機構 未来 ICT 研究所  
<sup>2</sup>株式会社タムラ製作所 コアテクノロジーセンター <sup>3</sup>株式会社光波)

6. 「超高耐圧 SiC パワーデバイスのデバイスシミュレーション」(16:50-17:30)

畠山 哲夫 (産業技術総合研究所 先進パワーエレクトロニクスセンター)

**意見交換会** (18:00 ~ 20:00) 9 F スズラン

会費：2,000 円 (ご同伴者は 5,000 円) を当日受付にて受領

---

<追記>

1. 委員会では、ご出席の回答をいただいた委員に昼食をご用意いたします。
2. 準備の都合上、委員会・研究会の出欠回答を 4 月 28 日(月)までに日本学術振興会研究事業課 中村 様 (jigyouka04@jsps. go. jp) 宛に、必ずご連絡くださいますようお願いいたします。
3. 研究会終了後に第 151 委員会と合同で意見交換会を開催いたします。  
ご出席の際には当日受付で会費 2,000 円 (ご同伴者は 5,000 円) をお支払いください。